

DUODIODE-PENTODE with variable mutual conductance for use as H.F. and I.F. amplifier

DUODIODE-PENTHODE à pente variable pour l'utilisation comme amplificatrice H.F. et M.F.

DUODIODE-PENTHODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung als H.F.- und Z.F. Verstärker

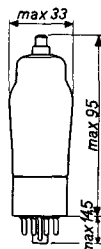
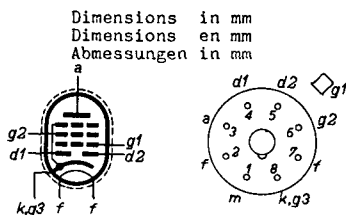
Heating: indirect by A.C. or D.C.;
series or parallel supply.

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.;
alimentation en parallèle
ou en série

Heizung: indirekt durch Wechsel-
oder Gleichstrom;
Serien- oder Parallel-
speisung

$V_f = 6,3 \text{ V}$

$I_f = 0,2 \text{ A}$



Capacitances
Capacités
Kapazitäten

Pentode section
Partie penthode
Penthodenteil

$C_{g1} = 3,9 \text{ pF}$

$C_a = 8,5 \text{ pF}$

$C_{ag1} < 0,002 \text{ pF}$

$C_{g1f} < 0,01 \text{ pF}$

Diode section
Partie diode
Diodenteil

$C_{d1k} = 2,9 \text{ pF}$

$C_{d2k} = 2,9 \text{ pF}$

$C_{d1d2} < 0,45 \text{ pF}$

Between diode and pentode sections
Entre les parties diode et penthode
Zwischen Dioden- und Penthodenteil

$C_{d1g1} < 0,001 \text{ pF}$

$C_{d2g1} < 0,001 \text{ pF}$

$C_{d1a} < 0,5 \text{ pF}$

$C_{d2a} < 0,25 \text{ pF}$

Operating characteristics of the pentode section as H.F. or I.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode comme amplificatrice H.F. ou M.F.

Betriebsdaten des Penthodenteiles als H.F.- oder Z.F. Verstärker

$V_a = V_b =$	250	200	100	V
$R_{g2} =$	95	60	0	k Ω
$R_k =$	300	300	300	Ω
$V_{g1} =$	-2 -38	-2 -32	-2 -16,5	V
$V_{g2} =$	100 250	100 200	100 100	V
$I_a =$	5,0 -	5,0 -	5,0 -	mA
$I_{g2} =$	1,6 -	1,6 -	1,6 -	mA
$S =$	1800 18	1800 18	1800 18	$\mu A/V$
$R_i =$	1,3 >10	1,0 >10	0,4 >10	M Ω

Limiting values of the pentode section

Caractéristiques limites de la partie penthode

Grenzdaten des Penthodenteiles

$V_{a_0} =$	max. 550 V	$V_{g2_0} =$	max. 550 V
$V_a =$	max. 300 V	$W_{g2} =$	max. 0,3 W
$W_a =$	max. 1,5 W	$I_k =$	max. 10 mA
$V_{g2} (I_a < 2 \text{ mA}) =$	max. 300 V	$R_{g1} =$	max. 3 M Ω
$V_{g2} (I_a = 5 \text{ mA}) =$	max. 125 V	$R_{fk} =$	max. 20 k Ω
$V_{g1} (I_{g1} = +0,3 \mu A) =$	max. -1,3 V	$V_{fk} =$	max. 100 V

Limiting values of the diode section

Caractéristiques limites de la partie diode

Grenzdaten des Diodenteiles

$V_{d1} =$	max. 200 V ¹⁾
$V_{d2} =$	max. 200 V ¹⁾
$I_{d1} =$	max. 0,8 mA
$I_{d2} =$	max. 0,8 mA
$V_{d1} (I_{d1} = +0,3 \mu A) =$	max. -1,3 V
$V_{d2} (I_{d2} = +0,3 \mu A) =$	max. -1,3 V
$R_{fk} =$	max. 20 k Ω
$V_{fk} =$	max. 100 V

1) Peak value; valeur de crête; Scheitelwert



	EBF32	
page	sheet	date
1	1	1948.11.08
2	2	1948.11.08
3	FP	1999.06.15